



# 产品规格书

808nm 高功率半导体激光二极管芯片



## 808nm 高功率半导体激光二极管芯片

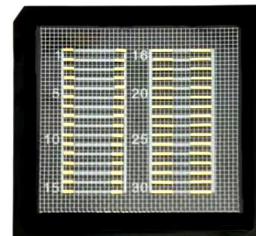
(LC-UMC-100-808-TE-3-2.0-D1)

### 性能特点

- GaAs 量子阱
- 高功率
- 高效率
- 高可靠性

### 典型应用

- 中高功率工业光纤激光器泵浦
- 生物医学
- 激光装备
- 科研



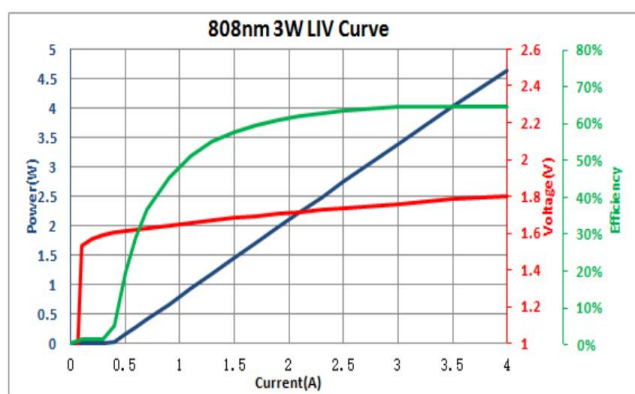
### 光电性能 (@Tc=25±3°C)

型号: LC-UMC-100-808-TE-3-2.0-D1					
Item	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
<b>Operation</b>					
Central Wavelength 中心波长 (CW)	$\lambda$	802	<b>805</b>	808	[nm]
Optical output power 输出功率	P <sub>opt</sub>		<b>3</b>		[W]
Operation mode 工作模式			<b>CW</b>		
Power modulation 功率调制率			<b>100</b>		[%]
<b>Geometrical</b>					
Emitter Width 出光窗口宽度	W		<b>100</b>		[ $\mu$ m]
Emitter Pitch 发光点周期	P		<b>500</b>		[ $\mu$ m]
Cavity Length 腔长	L	1900	<b>2000</b>	2010	[ $\mu$ m]
Thickness 厚度	D	110	<b>130</b>	150	[ $\mu$ m]
<b>Electro Optical Data</b>					
Fast Axis Divergency (FWHM) 快轴发散角	$\theta^{\perp}$		<b>36</b>	40	deg
Slow Axis Divergency (FWHM) 慢轴发散角	$\theta^{\parallel}$		<b>8</b>	10	deg
Spectral Bandwidth (FWHM) 光谱宽度	$\Delta\lambda$		<b>2</b>	3	[nm]
Pulse Wavelength 脉冲波长	$\lambda$	800	<b>803</b>	806	[nm]
Slope Efficiency 斜率效率	$\eta$	1.1	<b>1.28</b>		[W/A]
Conversion efficiency 转换效率		56	<b>61</b>		[%]
Threshold Current 阈值电流	I <sub>th</sub>		<b>0.4</b>	0.5	[A]
Operating Current 工作电流	I <sub>op</sub>		<b>2.8</b>	3	[A]
Operating Voltage 工作电压	V <sub>op</sub>		<b>1.75</b>	2	[V]
Temperature Characteristics (d $\lambda$ /dT) 温度特性			<b>0.28</b>		[nm/°C]
Polarization 偏振			<b>TE</b>		
LD Operating Temperature 工作温度		15	<b>25</b>	35	[°C]

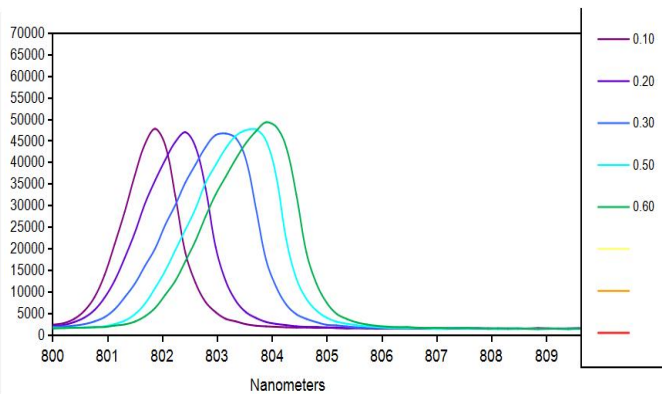
## 极限参数

参数名称	符号	额定值	单位
工作温度	Tc	-20 ~ +60	°C
存储温度	Tstg	-40 ~ +125	°C
最大输出功率	Pmax	6	W
最大正向电流	If	8	A

## 测试曲线



LIV 曲线



光谱曲线

说明:

- 1、单位：微米
- 2、发光区宽度：100微米
- 3、P电极：芯片正面，电极厚度0.3微米±0.03微米
- 4、N电极：芯片背面，电极厚度 0.6 微米±0.03 微米

### 注意事项

应采取必要的 ESD 防护措施，已避免芯片被静电损伤。

GaAs 基芯片易碎，取用时需十分小心。推荐使用真空吸附方式取用芯片。

焊接力度、温度等参数需小心设置，已避免损坏芯片。

